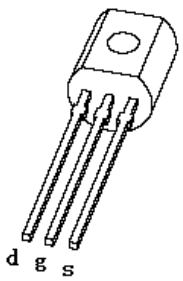
N 沟纵向 MOSFET



TO-92

描述:

N 沟增强型 VDMOS，高速开关，无二次击穿

产品应用:

- 电话机电路
- 继电器电路
- 驱动电路等

工作条件 (T=25℃)

符号	参数	极限值	单位
V_{DSS}	漏源电压	200	V
V_{GSS}	栅源电压	± 20	V
I_D	漏电流	300	mA
P_D	Power Dissipation for Dual Operation	1	W
Tj, T_{SDG}	结温度和存储温度	-55 to +150	℃

热特性

$R_{th\ j-a}$	Thermal Resistance, Junction to Ambient	125	**K/W**

电学特性 T_A=25℃

符号	参数	测试条件	最小	典型	最大	单位
BV_{DSS}	源漏击穿电压	$V_{GS}=0V$，$I_D=10uA$	200			V
I_{DSS}	零栅压时的漏极电流	$V_{DS}=160V$，$V_{GS}=0V$			1	uA
I_{GSS}	栅和衬底之间的漏电流	$V_{GS}=\pm 20V$，$V_{DS}=0V$			±100	nA
$V_{GS(th)}$	阈值电压	$V_{DS}=V_{GS}$，$I_D=1mA$	0.4		1.8	V
$R_{DS(on)}$	导通电阻	$V_{GS}=2.8V$，$I_D=100mA$			5	Ω

Downloaded from Elcodis.com electronic components distributor

交流特性

Ciss	输入电容	V_{DS}=25V，V_{GS}=0V f = 1MHz		120		pF
Coss	输出电容			30		pF
Crss	反馈电容			15		pF

开关特性

t_{on}	Turn-On 时间	V_{DD}=50V， I_D=250mA V_{GS}=0 to 10V		6	10	ns
t_{off}	Turn-Off 时间			49	60	ns

Downloaded from Elcodis.com electronic components distributor